

**GFP 5N60****概述**

**GFP 5N60** 是增强型 N 沟道功率场效应管，采用平面条形 DMOS 工艺生产制造。

**GFP5N60** 具有低导通电阻、优越的开关特性以及抗雪崩击穿能力，适合用于高效开关电源,电子镇流器等。



极限参数，除非另有规定， $T=25^{\circ}\text{C}$

参数	符号	额定值	单位
漏源反向击穿电压	$BV_{DSS}$	600	V
连续漏极电流	$I_D$	4.5	A
栅极电压	$V_{GS}$	$\pm 30$	V
雪崩能量	$E_{AS}$	210	mJ
耗散功率	$P_D$	100	W
储存温度	$T_{STG}$	-55 --150	$^{\circ}\text{C}$
热阻（结到壳）	$R^{\theta}_{JC}$	1.25	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
正向压降	$V_{SD}$	1.4	V

<b>东莞市华索电子有限公司</b> <a href="http://www.chinahaiso.com">http://www.chinahaiso.com</a>	<b>场效应晶体管</b>
	<b>GFP 5N60</b>

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
开启电压	$V_{GS(th)}$	2.0	-	4.0	V	$V_{DS}=V_{GS}$ , $I_D=250\mu A$
栅源漏电流	$I_{GSS}$	-	-	$\pm 100$	nA	$V_{GS}=\pm 30V$ , $V_{DS}=0V$
漏源漏电流	$I_{DSS}$	-	-	10	$\mu A$	$V_{DS}=600V$ , $V_{GS}=0V$
导通电阻	$R_{DS(on)}$	-	2.0	2.5	$\Omega$	$V_{GS}=10V$ , $I_D=2.25A$
跨导	$G_{fs}$	-	4.7		S	$V_{DS}=40V$ , $I_D=2.25A$
输入电容	$C_{iss}$	-	515	670	pF	$V_{GS}=0V$ , $V_{DS}=25V$ , $F=1.0MHz$
输出电容	$C_{oss}$	-	55	72		
传输电容	$C_{rss}$	-	6.5	8.5		
导通延迟时间	$t_d(on)$	-	16.5	45	ns	$V_{DD}=300V$ , $I_D=7.5A$ , $R_G=25\Omega$
上升时间	$t_r$	-	60.5	130		
下降延迟时间	$t_d(off)$	-	81	170		
下降时间	$t_f$	-	64.5	140		
栅极存储电荷	$Q_g$	-	28	36	nC	$V_{DS}=480V$ , $V_{GS}=10V$ , $I_D=7.5A$ ,
栅源电荷	$Q_{gs}$	-	4.5	-		
栅漏电荷	$Q_{gd}$	-	12	-		